



模拟电子技术A 赵宇帆 1120193570 06011908

3. UGD A -4 -6 -4 -16
UGS /V -1 -2 -6

UDS /V 3 4 2 10

工作区 b a b C

已知型号为 N沟道结型

当 UGS < UGS (0ff) 截止

当 UGS > UGS (0ff) UGD < UGS (0ff) 饱和

当 UGS > UGS(off) NGD > UGS(off) 可変电阻

根据以上关系知 4个空体次为

4 (a) 该场效应管为 N沟道结型场效应管

由图可知,分析静态时, Uas=0

由 Ida= IDSS (1- uas uascoff)2 = IDSS 知,此时ID电流很大

静态工作点太高,动态范围太小,不能正常放大

(b) 该场效应管为N沟道於耗尽型Mos管

由于漏极没有电阻,被放大的支流信号对地短路,信号无法输出,故无法 实现放大

(c) 该场效应量为N沟值增强型Mos管

输入、输出均正常, ugs>O围过RGI、Raz的选择可使其工作在饱和区

(d) 该场效应签为N沟值增强型MOS管

UGS = -Ip. QS < O < UQS(th), 无法实现放大功能



北京理工大学 REIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(2) 该场效应管为N沟道结型

E知 Was = -2v 富満足 Wapf Was(off) = -4v Wpg >4v

EP Ubs = Ubg tugs > 2 V

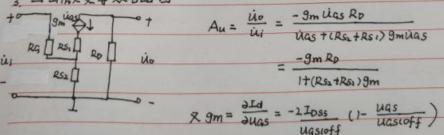
UDS = 20- (14+RSx).0.5 > 2V

1 RS2 < 11kg

RS2 < 22KA

別 Rs2 阻值不应超过22KA

3 画出微变等效电路图

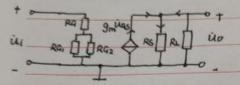


= 0.5 ms 代入上於得 Au= -5/4 ≈ -0.36



11.

画出微变等效电路



U'L = RS 1/RL = 6 KA

$$Au = \frac{\dot{u}_0}{\dot{u}_1} = \frac{g_{\text{mias}} R_L^2}{\dot{u}_{\text{GS}} + g_{\text{migs}} R_L^2} = \frac{g_{\text{mRL}}}{1 + g_{\text{mRL}}} = \frac{b}{7} \approx 0.857$$

Ri = RG + RG, 1/RG2 = 2075KA

$$Ro = \frac{\dot{U}_0}{\dot{I}_0} = \frac{-\dot{U}_0 s}{-g_m u_{0s} - \frac{\dot{u}_0 s}{Rs}} = \frac{\dot{g}_m}{g_m + \frac{1}{Rs}} = \frac{\dot{R}_s}{g_m} = \frac{12}{13} kn \approx 0.92 kn$$